

Electron Beam Lithography System Based on SEM

DY-2000A



● 加速电压: 1—30kV	● 电子束直径: 6 nm	● 电子束流: 4 pA—10 nA
● 最细线宽: 20 nm	● 扫描速度: 5 MHz	● 图形尺寸精度: 0.06 μm
● 场拼接精度: 0.1 μm	● 单场曝光范围: 10—1 000 μm	● 位移台运动范围: 50 mm×50 mm

微纳米器件制作、新型半导体器件研究

多场拼接游标图

16.8 nm 线图形

65 nm 等间距光栅

微耦合电路

中国科学院院刊 | 149